第28卷第12期

催化学报

Chinese Journal of Catalysis

2007年12月 December 2007

文章编号:0253-9837(2007)12-1107-05

研究论文:1107~1111

# 镍掺杂的镁(0001)面上氢气解离的密度泛函理论研究

江  $j_{1,2}$ , 褚海亮<sup>2</sup>, 齐艳 $u_{2}$ , 李微雪<sup>1</sup>, 孙立贤<sup>2</sup>

(1 中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室, 辽宁大连 116023;

2 中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连 116023)

摘要:采用密度泛函理论研究了氢气在镍掺杂的镁(0001)面上的解离吸附过程.通过固定键长法计算得到氢分子在镍掺杂 的镁(0001)面上的解离能垒为0.09 eV,而在清洁镁(0001)面上,氢气的解离能垒为1.15 eV.电子结构分析表明,解离能垒 的降低是由于氢分子与表面镍原子形成反馈键并被填充所致.这一计算结果表明,在镁中加入过渡金属催化剂会大大提高储 氢材料的动力学性能.

关键词:镍;镁;掺杂;储氢材料;密度泛函理论;氢气;解离 中图分类号:O643 文献标识码:A

## Density Functional Theory Study of Hydrogen Dissociation on Ni-Doped Magnesium (0001) Surface

JIANG Tao<sup>1,2</sup>, CHU Hailiang<sup>2</sup>, QI Yanni<sup>2</sup>, LI Weixue<sup>1,\*</sup>, SUN Lixian<sup>1,\*</sup>

(1 State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, The Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, Liaoning, China; 2 Dalian Institute of Chemical Physics, The Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, Liaoning, China)

Abstract : Hydrogen dissociation on Ni-doped Mg( 0001 ) surface was studied by density functional theory calculations. Using the fixed-bond method , a dissociation barrier of 0.09 eV was obtained in contrast to 1.15 eV on a clean Mg( 0001 ) surface reported in the literature. Electronic structure analysis shows that the decrease of the dissociation barrier comes from filling of the  $\sigma^*$  orbital due to the back donation through the doped Ni atom. The results indicate that the kinetics of hydrogen uptake is dramatically enhanced by doping transition metal catalysts.

Key words : nickel ; magnesium ; doping ; hydrogen storage material ; density functional theory ; hydrogen ; dissociation

氢气由于储量丰富及环境友好,被认为是一种 理想的能量载体. 然而,在氢能实际应用之前,仍有 一些关键问题需要解决,氢气的储存就是其中之一. 镁具有较高的理论储氢质量比(7.6%),并且在地 球上的储量丰富,价格低廉,被认为是一种较好的储 氢材料<sup>[12]</sup>. 然而镁基储氢材料较慢的吸放氢动力 学及过于稳定的氢化物限制了它的实际应用. 其动 力学较差的原因之一是氢气难以在镁的表面上解 离<sup>[34]</sup>.

实验上,人们通过球磨的方法将过渡金属与镁制成合金,利用过渡金属作为催化剂为氢气提供解 离途径来提高储氢材料的动力学性能<sup>[5~9]</sup>.然而, 加入的过渡金属对氢气解离的催化机理,及其可能 导致氢化物更加稳定等问题仍不清楚.最近,文献

联系人:李微雪. Tel: (0411)84379996; E-mail: wxli@dicp.ac.cn. 孙立贤. Tel: (0411)84379213; E-mail: lxsun@dicp.ac.cn. 基金来源:国家自然科学基金(20503030,20473091,50671098,20573112,U0734005); 中国科学院"百人计划";国家高技术研究 发展计划(2007AA05Z115,2007AA05Z102).

收稿日期:2007-06-16. 第一作者: 江 涛, 男, 1982年生, 硕士研究生.

[10,11]报道了氢气在干净和用铂改性的镁膜表面 的吸附和脱附性能.研究发现,加入 Pt 后, Mg 的 吸氢活性和吸附量均大幅度提高,其原因被归结为 Pt 对氢解离的促进作用.

理论上, Nørskov 等<sup>[12]</sup>采用凝胶模型研究了氢 气在镁(0001)面上的解离,发现在解离之前存在一 个化学吸附态,并计算得到解离能垒为0.5 eV. Vegge<sup>[13]</sup>采用更为精确的改进的Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)泛函,配合弹性带方法重新计算, 得到氢气在镁(0001)面桥位上的解离能垒高达 1.15 eV;同时研究发现,氢原子从表面向亚表层扩 散并最终向体相扩散的能垒分别为0.53 和0.18 eV. 因此, Mg 储氢材料吸氢过程的速控步骤为氢 气的解离. Jacobson 等<sup>[14]</sup>也计算了氢原子向镁体相 扩散的能垒,得到的结果为0.155 eV, 与 Vegge<sup>[13]</sup> 得到的0.14 eV 的结果相近.

为了了解掺杂的过渡金属对镁基储氢材料的作用,人们对掺杂体系进行了密度泛函理论(DFT)计算,然而这些计算局限于将体相镁原子用过渡金属替换,因而只是考察了掺杂对体相储氢的影响<sup>[15~17]</sup>. Du 等<sup>[18]</sup>对表面用钛替代了的镁表面上氢气的解离进行了研究,发现表面存在钛原子时,氢的解离能垒降至 0.1 eV. Ni 催化剂也被广范用于提高 Mg 的吸氢性能,但其微观上的解离过程还不清楚.本文通过理论计算详细研究了镍掺杂的镁(0001)面上氢气的解离过程,计算了解离过程的势能曲线,并对氢分子解离过程及其机理进行了探讨.

#### 1 计算方法及模型

DFT 总能计算采用基于超软赝势<sup>[19]</sup>和平面波 的 DACAPO 计算软件包<sup>[20]</sup>. 波函数由平面波展 开,其动能截断为 350 eV.采用广义梯度近似中的 Perdew-Wang91(PW91)交换关联泛函描述电子间 的交换关联相互作用.本文采用 5 个原子层厚的(2 ×2) 候平板模型来讨论氢气在其上的解离吸附过 程,其中表面上的一个镁原子被镍原子替代(见图 1),平板之间用 1.2 nm 的真空层隔开,以保证平板 间的相互作用足够小.采用 Monkhorst-Pack 方法选 取表面布里渊区 k 点<sup>[21]</sup>,对于(2×2)的镁(0001) 面表面构型的超胞,采用(4×4×1)的 k 点取样.吸 附氢原子放在基底表面的一侧,为减小吸附产生的 诱导偶极的影响,计算中应用了偶极子校正.对氢 原子及最外三层基底原子进行结构弛豫,弛豫结束



图 1 镍掺杂的镁(0001)面的顶视图和侧视图 Fig 1 Top view(a) and side view(b) of Ni-doped Mg(0001) surface (Different colours are used to denote different layers of Mg atoms, and fcc and hcp are two different adsorption sites.)

的判断标准为原子间力的最大值小于 0.2 eV/nm. 计算中应用了费米函数,其温度展宽因子为  $k_{\rm B}T =$  0.15 eV,并且最终得到的总能被外推到绝对零度.

文中所用的平均吸附能  $E_{ad}$  定义为  $E_{ad}$  = ( $E_{H/Mg-Ni} - E_{Mg-Ni} - 0.5 \times N \times E_{H_2}/N$ ),其中,  $E_{H/Mg-Ni}$ , $E_{Mg-Ni}$ 及 $E_{H_2}$ 分别表示吸附体系、镍掺杂 的镁表面以及气相中氢分子的总能,N为体系里 H 原子的数目.根据此公式所得吸附能为负值时,代 表吸附为放热反应.

文中采用固定键长法寻找氢气在表面上解离的 过渡态. 其具体做法为固定氢气分子键长在某一长 度,同时允许氢分子和表面弛豫其坐标,使得到的体 系能量最小. 由于某一键长的氢分子在表面可能有 多个吸附能的极小值,为了找到真正的最小能量,本 文采用逆推法,即从解离吸附的终态出发,逐渐缩短 氢分子键长,同时弛豫其坐标,直至氢分子键长与气 相中的相等. 得到的过渡态能量与气相中氢分子及 干净表面的总能差即为氢分子在镁及改性后的镁表 面解离的能垒.

#### 2 结果与讨论

### 2.1 氢气在镍掺杂的镁(0001)面上的解离

我们首先对吸附前表面进行了弛豫,弛豫后镍 原子稍微向下移动,其 <sup>2</sup> 方向坐标低于同层镁原子 0.058 nm.氢分子的初态距表面距离为0.425 nm. 为了确定反应的终态,我们对两个氢原子在(2×2) 表面上的吸附进行了研究.由于表面上镍替代了一 个镁原子,因此表面的 hollow 位分为两种,一种为 邻近镍原子的 hollow 位(称为第一近邻 hollow 位), 另一种为远离镍原子的 hollow 位(称为第二近邻 hollow 位).由于本文的研究目的是揭示表面镍原 子对氢气分子解离的影响,氢分子的解离在镍的周 围完成,解离后两个氢原子吸附在两个第一近邻的 hollow 位上,因此我们考察了两个氢原子同时在第 一近邻 hollow 位上吸附的不同构型(如图 2 所示), 并将最稳定的吸附态作为反应的终态.



图 2 氢分子在镍掺杂的镁(0001)面上的吸附构型 Fig 2 Adsorption structure of hydrogen molecules on Ni-doped Mg(0001) surface(top view) (a) fcc-2,(b) hcp-2,(c) fcc-hcp

计算表明,fcc-2 构型的吸附能为-0.346 eV, hcp-2 构型为-0.352 eV,fcc-hcp 构型为-0.346 eV,其差别小于0.01 eV.在这里我们选取吸附能 最低的 hcp-2 构型作为反应的终态来研究表面镍原 子对氢气解离反应的影响.在此构型下,两个氢原 子分别高于镍原子0.09 和0.1 nm,氢原子与镍之 间的键长分别为0.16 和0.161 nm,氢原子与最近 邻的镁原子之间的键长为0.206 和0.209 nm.

2.2 氢气解离的势能曲线

氢分子在镍掺杂的镁(0001)面上解离过程的势 能面及势能面上相应的亚稳态的结构如图 3 所示. 可以看到,氢分子逐渐靠近表面时,首先会遇到一个 位于镍原子正上方的能垒(TS1),越过此能垒后体



图 3 氢分子在镍掺杂的镁(0001)面上解离的势能面 Fig 3 Potential energy surface of hydrogen molecule dissociation on Ni-doped Mg(0001) surface

系能量达到第一个局域极小值,对应于氢分子的化 学吸附态(CS).随后氢分子将在镍原子的顶位发生 解离(图3第二个能垒TS2),解离完成后两个氢原 子分别到达镍原子紧邻的 hcp 位,体系能量达到第 二个极小值,对应于反应的终态(FS).

整个解离过程中存在两个过渡态,第一个过渡 态(TS1)出现在氢分子质心高于镍原子 0.28 nm 处,氢分子键长为 0.076 nm,能垒高度为 0.09 eV. 在此过渡态之前氢分子的键长保持与其在气相中相 同的 0.075 nm,而通过之后氢分子的键长开始拉 长,故此过渡态对应于氢分子在改性镁表面的物理 吸附向化学吸附的转变.第二个能垒(TS2)为氢分 子的解离能垒,相对于化学吸附氢分子的能垒高度 为 0.08 eV,此时氢分子在镍原子上方 0.138 nm 处,解离时两个氢原子之间的距离为 0.125 nm,氢 原子与镍原子之间的键长为 0.152 nm.相比氢分 子在干净镁表面的解离(1.15 eV)而言<sup>[13]</sup>,这么小 的活化能意味着氢分子在掺杂镁表面的解离很容易 完成,即加入金属催化剂后可以显著改进镁的吸氢 动力学.

第一个极小值(CS)对应于氢分子在表面的化 学吸附态(见图3),氢分子位于镍原子顶位附近,其 质心高于镍原子 0.148 nm,氢分子键长拉长至 0.095 nm,氢原子与镍原子的键长为 0.158 nm,化 学吸附能为 -0.17 eV.另外,在解离的终态(图 2(b))处,氢的吸附能为 -0.35 eV.而在干净镁 (0001)面上吸附相同覆盖度(0.5 单层)的氢原子时 相应的吸附能为  $-0.1 \text{ eV}^{[22]}$ .本文中吸附能较干 净镁表面增强是由于镍与氢之间较强的相互作用. 我们同样考察了 PBE 泛函给出的反应能垒 ,其结果 与 PW91 泛函的结果仅相差几个 meV ,因此不同泛 函差别的影响可忽略不计。

与 Nørskov 等<sup>[12]</sup>报道的氢分子在镁(0001)面 上的解离过程比较可以发现,本文所描述的氢气的 解离过程以及第一个过渡态(TS1)和化学吸附态 (CS)的几何构型与 Nørskov等的结果非常相近.这 是由于解离之前,氢分子距表面较远,与表面相互作 用较弱,因而两种情况所得结果相一致.两个表面 上解离过程的差异是从第二能垒(TS2),即氢分子 的解离开始的,这主要是源于氢分子与两个不同表 面的相互作用的差异.

2.3 氢气在镍掺杂的镁(0001)面上解离的机理

为了深入了解氢气解离过程中表面镍原子对氢 气解离影响的内在机理,我们进行了相应的电子结 构分析. 镍掺杂镁表面上解离反应过渡态以及终态 的投影态密度如图 4 所示. 由图 4(a)可以看出,过 渡态时,氢分子的态密度主要集中在 -7.2 和 -3.6eV 这两个能级附近,分别对应氢分子的 $\sigma$ 成键轨道 和 $\sigma^*$ 反键轨道. 相应成键轨道的波函数如图 5(a) 所示,由该图可以看出,成键轨道与 Ni的 d 轨道的 相互作用很小,结合相应的态密度可知,主要是表面 离域的 s 轨道和 p 轨道参与了相互作用. 与氢分子 反键轨道作用的只有镍原子的 d 轨道,相应能级上 的波函数(图 5(b))显示出 Ni 的  $d_{xx}$  或  $d_{yx}$  轨道与 氢分子的反键轨道交叠很好. 因此,氢分子反键轨 道与基底的相互作用主要集中在氢分子与镍原子之 间.

为了了解过渡态的电荷转移情况,我们计算了 其差分电荷密度,结果如图 5(c)所示.可以看出,氢



图 4 过渡态和终态表面镁、镍和氢原子的投影态密度 Fig 4 Projected density of states (PDOS) of surface Mg, Ni, and H atoms at transition state(a) and final state(b)

分子的成键  $\sigma$  轨道和镍原子的  $d_{z^2}$  轨道所处的区域 电荷密度降低 ,而氢分子反键  $\sigma^*$  和镍原子的  $d_{xz}$  或  $d_{yz}$  轨道所处区域电荷密度升高.结合上面的态密 度分析可知 ,氢分子与表面镍原子成键时 ,氢分子的  $\sigma$  轨道与镍的  $d_{z^2}$  交叠 ,并将电子转移到镍上 ,而镍 原子又通过  $d_{xz}$  或  $d_{yz}$  轨道将电子反馈回氢分子的  $\sigma^*$  轨道 ,从而削弱两个氢原子之间的成键作用 ,使 得氢分子的解离能垒大幅度降低.



( The dark and light area represents the increasing and decreasing of charge density , respectively. The unmentioned black spheres represent Mg atoms. )

当氢分子完成解离并吸附在表面上时,其态密 度(图4(b))显示,此时镍d轨道的电子布居主要集 中在 -4 eV以上的高能级,低能级仅在 -5 eV附近 有少量的分布;而氢原子 s轨道的电子则主要分布 在 -4 eV以下的低能级处.同时,在过渡态附近氢 分子和镍轨道在 -3.6 eV处的杂化在终态时消失. 这说明在终态时,解离的氢原子和镍d轨道之间的 成键相互作用被削弱.氢和衬底的相互作用主要来 源于氢的 s轨道与基底的 s和 p轨道之间的杂化.

#### 3 结论

采用密度泛函理论计算研究了氢分子在镍掺杂 镁(0001)面上解离的过程.在镁表面上掺杂少量的 镍原子能够使氢分子的解离能垒从1.15 eV 降低至 0.09 eV.这是由于在过渡态处,氢分子与表面镍原 子 d 轨道形成反馈键,氢分子的  $\sigma$  成键轨道与镍原 子的  $d_{z^2}$  轨道交叠, $\sigma^*$  反键轨道与镍原子的  $d_{xz}$  或  $d_{yz}$  轨道交叠,氢分子  $\sigma$  成键轨道上的电子通过表面 镍原子传递到  $\sigma^*$  反键轨道上,并使得 H-H 键被削 弱,从而降低了解离能垒.当解离反应完成后,H 和镍 d 轨道的相互作用削弱,H和表面的相互作用 主要来源于 H 原子和衬底的 s 轨道和 p 轨道的相 互作用.

#### 参考文献

- 1 Schlapbach L , Zuttel A. Nature , 2001 , 414(6861):353
- 2 Schwarz R B. MRS Bull , 1999 , 24(11):40
- 3 Zaluska A, Zaluski L, Storm-Olsen J O. Appl Phys A, 2001, 72(2):157
- 4 Von Zeppelin F , Reule H , Hirscher M. J Alloys Compd ,

2002 , 330-332 : 723

- 5 Bobet J L , Chevalier B , Darriet B. J Alloys Compd , 2002 , 330-332:738
- 6 Rivoirard S, de Rango P, Fruchart D, Charbonnier J, Vempaire D. J Alloys Compd, 2003, 356-357:622
- 7 Liang G. J Alloys Compd , 2004 , 370(1-2):123
- 8 Hanada N , Ichikawa T , Fujii H. J Phys Chem B , 2005 , 109(15):7188
- 9 Yavari A R , De Castro J F R , Vaughan G , Heunen G. J Alloys Compd , 2003 , 353(1-2):246
- 10 Johansson M , Ostenfeld C W , Chorkendorff I. *Phys Rev* B , 2006 , **74**(19):193408
- 11 Ostenfeld C W , Johansson M , Chorkendorff I. Surf Sci , 2007 , 601(8):1862
- Nørskov J K , Houmøller A , Johansson P K , Lundqvist B
  I. Phys Rev Lett , 1981 , 46(4):257
- 13 Vegge T. Phys Rev B , 2004 , 70(3):035412
- 14 Jacobson N, Tegner B, Schroder E, Hyldgaard P, Lundqvist B I. Comput Mater Sci , 2002, 24(1-2):273
- 15 Shang C X , Bououdina M , Song Y , Guo Z X. Int J Hydrogen Energy , 2004 , 29(1):73
- 16 Song Y , Guo Z X , Yang R. Phys Rev B , 2004 , 69(9): 094205
- 17 Vegge T, Hedegaard-Jensen L S, Bonde J, Munter T R, Nørskov J K. J Alloy Compd, 2005, 386 (1-2):1
- 18 Du A J , Smith S C , Yao X D , Lu G Q. J Phys Chem B , 2005 , 109(38):18037
- 19 Vanderbilt D. Phys Rev B , 1990 , 41(11):7892
- 20 Hammer B , Hansen L B , Nørskov J K. Phys Rev B , 1999 , 59(11):7413
- 21 Monkhorst H J , Pack J D. Phys Rev B , 1976 , 13(12): 5188
- 22 Jiang T , Sun L X , Li W X. Phys $\mathit{Rev}\ B$  , submitted

(Ed ChRH)